

STA405A

NPNシリコン三重拡散プレーナ型ダーリントン トランジスタ(I)

特長 ●高直流電流増幅率。

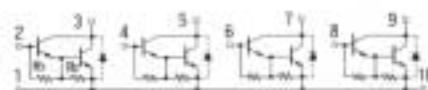
■絶対最大定格

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{cb}	100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{ce}	80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{eb}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{cp}	8	A
コレクタ電流	I_c	4	A
全許容損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_D	20	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-30 ~ +150	$^\circ\text{C}$

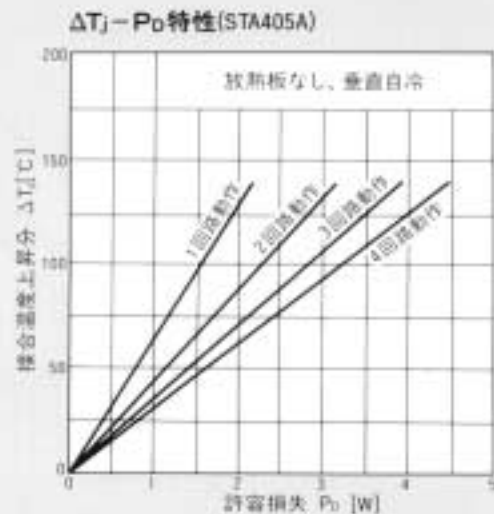
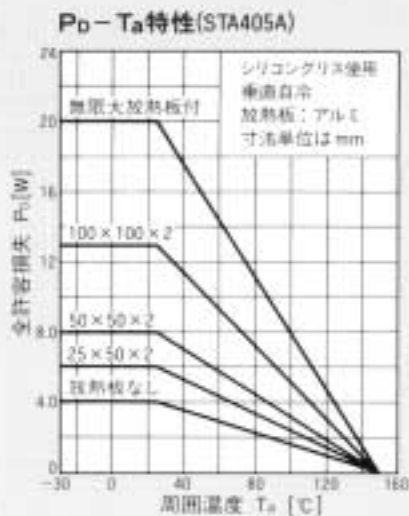
■等価回路

STA405A: NPN4回路



$R_1: 3\text{k}\Omega \text{ Typ}$ $R_2: 150\Omega \text{ Typ}$

特性曲線



■電気的特性

(Ta = 25°C)

項目	記号	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CE} = 100V, I_B = 0$			100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{BE} = 6V, I_C = 0$			10	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 10mA, I_B = 0$	80			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 4V, I_C = 3A$	1000			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3A, I_B = 10mA$			2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 3A, I_{B1} = -I_{B2} = 10mA$		1.0		μs
蓄積時間	t_s			4.0		μs
下り時間	t_f			1.5		μs

